

## 拒絶理由通知書

特許出願の番号	平成 9年 特許願 第264225号
起案日	平成11年 5月24日
特許庁審査官	小原 博生 9814 2K00
特許出願人代理人	京本 直樹 (外 2名) 殿
適用条文	第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出されたい。

## 理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項1～12、14～17：引用文献1～2

請求項13、18：引用文献1～3

備考：

(1) 請求項1～12、14～17について

引用文献1については、【0030】～【0033】、図9及び図10を参照されたい。

なお、n型基板を用い、p型半導体層を選択成長した利得導波型の半導体レーザは、引用文献2にも記載されているように、周知である。

(2) 請求項13、18について

続葉有

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。